

Гостищев Павел Андреевич

**Сl-анионное легирование тонкопленочных галогенидных перовскитов для
инвертированных р-і-п солнечных элементов и модулей с повышенной
фотостабильностью**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

**Специальность 2.2.3 – «Технология и оборудование для производства материалов и
приборов электронной техники»**

Работа выполнена на кафедре полупроводниковой электроники и физики полупроводников и в лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС»

Научный руководитель: к.т.н., заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики НИТУ «МИСиС» Альдо Ди Карло

Экспертная комиссия:

1. Ховайло Владимир Васильевич – д.ф.-м. н., профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;
2. Мухин Сергей Иванович – д.ф.-м. н., заведующий кафедрой теоретической физики и квантовых технологий НИТУ «МИСиС»;
3. Таперо Константин Иванович- д.т. н, заместитель генерального директора по науке и инновациям АО «Научно-исследовательский институт приборов», ГК «Росатом»;
4. Якимов Евгений Борисович - д.ф.-м. н., заведующий лабораторией локальной диагностики полупроводниковых материалов федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук
5. Тамеев Алексей Раисович– д.ф.-м. н., главный научный сотрудник Лаборатории электронных и фотонных процессов в полимерных материалах федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук

Ведущее предприятие:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования и науки Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Академический Университет им. Ж.И. Алферова Российской академии наук, г. Санкт-Петербург.

Защита диссертации состоится «27» декабря 2022 года по адресу 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 2.